УДК 537.624.9

## ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖСЛОЕВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ТРЕХСЛОЙНЫХ ПЛЕНКАХ FeNi/Bi/FeNi

© 2012 г. Г. С. Патрин<sup>1, 2</sup>, В. Ю. Яковчук<sup>1</sup>, Д. А. Великанов<sup>1</sup>, К. Г. Патрин<sup>1, 2</sup>, С. А. Яриков<sup>1</sup>

*E-mail: patrin@iph.krasn.ru* 

В работе приведены результаты экспериментальных исследований межслоевых взаимодействий в пленках FeNi/Bi/FeNi. Методами СКВИД-магнитометрии и магнитного резонанса показано, что межслоевое взаимодействие зависит как от толщины висмутовой прослойки, так и от температуры. Обнаружен эффект гигантского магнитосопротивления.

Многослойные магнитные пленки с неметаллической прослойкой, в частности, в системе ферромагнитный металл/полупроводник [1] или с полуметаллической прослойкой привлекают внимание исследователей в силу богатого разнообразия эффектов, наблюдаемых в этих пленках. Когда в качестве прослойки используется полупроводниковый материал, возникает возможность управлять свойствами прослойки и межслоевого взаимодействия (*J*) путем внешних воздействий (примеси, различного рода излучения, температура, магнитные поля и т.д.).

В таком плане создание пленочных структур, которые сохранили бы чувствительность к внешним воздействиям, но обладали бы большими эффектами взаимодействия между магнитными слоями, представляет собой заманчивую задачу. Один из путей решения этой проблемы видится в использовании полуметаллической прослойки Ві вместо полупроводникового материала. Во-первых, согласно фазовой диаграмме [2], в системах 3d-металл-висмут большинство элементов не образуют соединений. Во-вторых, висмут сам по себе обладает необычными физическими свойствами как для объемных, так и для пленочных образцов. В висмуте длина свободного пробега электрона может достигать макроскопических масштабов, при этом она зависит от толщины слоя, температуры и магнитного поля, также меняются концентрация и подвижность носителей тока.

Ранее [3] нами были впервые синтезированы и исследованы трехслойные пленки NiFe/Bi/NiFe. Пермаллой был выбран в качестве магнитного слоя в силу его малой магнитной кристаллографической анизотропии, чтобы не затушевывать межслоевое взаимодействие. Были синтезированы пленки с разными соотношениями содержания железа и никеля, чтобы проследить за конкуренцией собственной магнитной энергии и энергии межслоевого взаимодействия на формирование магнитного состояния. Для всех пленок толщины магнитного слоя были  $t_{\rm NiFe} \approx 10$  нм, а толщина висмута варьировалась в пределах  $t_{\rm Bi} = 3 - 15$  нм. Величина *t*<sub>NiFe</sub> была выбрана из соображений, чтобы она была довольно малой, но в то же время достаточной для того, чтобы намагниченность магнитного слоя более не менялась от его толщины. Толщины слоев определялись методами рентгеновской спектроскопии. Электронно-микроскопические исследования показали, что слои являются сплошными по площади и их состав соответствует номинальному. Никаких следов присутствия 3d-Вi-соединений не обнаружено. Измерения магнитных и температурных зависимостей намагниченности показали, что межслоевое взаимодействие зависит от толщины висмутовой прослойки. Установлено, что форма кривой  $\sigma(H)$  изменяется при увеличении толщины слоя висмута (см. рис. 1). В частности, для контрольной пленки с  $t_{\rm Bi} = 0$  петля гистерезиса является узкой и кривая намагниченности имеет ферромагнитный тип. Для пленок с  $t_{\rm Bi} \neq 0$  ширина гистерезиса кривых намагничивания немонотонно зависит от толщины t<sub>Bi</sub>, что связывается с включением межслоевого взаимодействия. Коэрцитивная сила ( $H_C$ ) увеличивается по мере увеличения толщины висмутовой прослойки почти в 3 раза, достигая максимума около  $t_{\rm Bi} \sim 13$  нм, и затем снова уменьшается. Этот результат согласуется с результатами работы [4], где установлено, что период осцилляций межслоевого взаимодействия в пленках СоFe/Bi/СоFe составляет более 10 нм. Из вида кривых намагничивания видно, что при комнатных температурах межслоевая связь ослабевает настолько, что четко прослеживаются вклады от разных слоев [5]. При этом коэрцитивная сила при комнатных температурах уменьшается более чем на порядок.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Учреждение Российской академии наук Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, Красноярск.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Сибирский федеральный университет, Красноярск.



**Рис. 1.** Полевые зависимости намагниченности пленок NiFe/Bi/NiFe: a - T = 4.2 K,  $\delta - T = 300$  K.  $t_{NiFe} = 10$  нм (1, 2, 3, 4);  $t_{Bi} = 0, 8, 13$  и 15 нм соответственно.

Были также проведены спектральные исследования полярного эффекта Керра в диапазоне длин волн  $\lambda = 400-800$  нм при комнатной температуре. В этом случае также не наблюдаются простые по-



**Рис. 2.** Спектры магнитного резонанса пленок NiFe/Bi/NiFe при разных толщинах висмута;  $t_{\text{NiFe}} = 10$  нм, a – пленки с  $1 - t_{\text{Bi}} = 0$  нм и  $2 - t_{\text{Bi}} = 15$  нм;  $\delta$  – пленка с  $t_{\text{Bi}} = 6$  нм. На вставках приведены температурные зависимости значений резонансного поля соответствующих пленок, LF и HF – низкочастотная и высокочастотная ветви колебаний.

добные друг другу зависимости от толщины висмутовой прослойки.

Однако магнитостатические данные не позволяют однозначно ответить на вопрос о величине и поведении межслоевого взаимодействия, поэтому мы использовали метод электронного магнитного резонанса с целью изучения характера изменения межслоевого обмена при изменении температуры.

Установлено, что в интервале толщин висмута  $t_{\text{Bi}} = 3-12$  нм спектр магнитного резонанса состоит из двух линий (см. рис. 2), что указывает на антиферромагнитный характер межслоевого взаимодействия между ферромагнитными слоями. Для контрольной пленки с  $t_{\text{Bi}} = 0$  нм и для пленок с  $t_{\text{Bi}} \ge 15$  нм наблюдается одиночная линия магнитного резонанса. Были измерены температурные зависимости параметров магнитного резонанса, использованные для установления температурных зависимостей *J* (см. вставки на рис. 2).

Экспериментальные результаты были обработаны путем теоретической подгонки спектров магнитного резонанса для трехслойной магнитной пленки. В применении к нашему случаю свободная энергия на единицу площади имеет следующий вид:

$$E = -J\cos(\varphi_1 - \varphi_2) - t_{FM} \Big[ \vec{H} \Big( \vec{M}_1 + \vec{M}_2 \Big) - 4\pi \Big( M_{1Z}^2 + M_{2Z}^2 \Big) \Big], \tag{1}$$

где J — константа межслоевого обменного взаимодействия,  $\vec{H}$  — внешнее магнитное поле,  $\vec{M}_i$  намагниченность *i*-го ферромагнитного слоя,  $\varphi_i$  — угол намагниченности в плоскости пленки (отсчитываемый от направления внешнего магнитного поля), i = 1, 2 нумеруют ферромагнитные слои,  $t_{\rm FM}$  — толщина магнитного слоя, ось Zперпендикулярна плоскости пленки. При вычислении мы полагаем, что ( $t_{FM}HM$ )  $\gg J$  и ферро-

206

магнитные слои находятся в насыщенном состоянии, так что  $\phi_i \approx \phi_H = 0$ . Также предполагается, что оба ферромагнитных слоя идентичны. При этих условиях резонансные частоты даются следующими выражениями:

$$\left(\omega_{1}/\gamma\right)^{2} = H\left(H + H_{M}\right),\tag{2}$$

 $(\omega_2/\gamma)^2 = H(H + H_M) + 2(2H + H_M)H_J + 4H_J^2$ , (3) Fine

$$H_M = 4\pi M$$
 и  $H_J = J/(t_{FM}M).$  (4)

Поскольку величины  $\omega$ , H, и M известны из эксперимента, можно, используя выражение (3), легко найти  $H_J$  и затем из выражения (4) определить константу межслоевого взаимодействия J.

Обработка температурных зависимостей резонансного поля позволила установить температурные зависимости межслоевого взаимодействия (см. рис. 3).

Как видно из рис. 3, константа межслоевого взаимодействия зависит от температуры, слабо увеличиваясь по величине с ростом температуры, при T = 100 К обменное поле  $H_J = J/(t_{\text{NiFe}}\sigma)$  примерно равно -150, -200, -250 и +400 Э для пленок с  $t_{\text{Bi}} = 4$ , 6, 12, 15 нм соответственно. При температурах  $T \ge 225$  К константы выходят на одинаковую зависимость. Но при больших толщинах висмута взаимодействие между ферромагнитными слоями еще заметно проявляется, что следует из смещения линии магнитного поглощения для пленки с  $t_{\text{Bi}} = 15$  нм относительно контрольной пленки  $t_{\text{Bi}} = 0$  нм и ее бо́льшей ширины линии.

В этих пленках были обнаружены магнитосопротивление порядка единицы процентов и зависимость его величины от толщины висмутовой прослойки. Но этот момент будет предметом отдельного исследования.

Основные полученные экспериментальные результаты сводятся к следующему:



**Рис. 3.** Рассчитанные температурные зависимости обменного поля для пленок NiFe/Bi/NiFe. *1*, *2*, *3*, *4* –  $t_{\text{Bi}} = 4$ , 6, 12, 15 нм соответственно.

обнаружено влияние полуметаллической прослойки Ві на величину и знак межслоевого взаимодействия в структуре NiFe/Bi/NiFe, зависящее от толщины немагнитной прослойки;

методом магнитного резонанса показана зависимость межслоевого взаимодействия от температуры.

Настоящие исследования ведутся при финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-02-00675-а).

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Patrin G.S., Vas'kovskii V.O. // Fiz. Met. Metall. 2006. V. 101. Suppl. 1. P. S63.
- 2. Денисов В.М., Белоусова Н.В., Моисеев Г.С. и др. Висмутсодержащие материалы: Структура и физико-химические свойства. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2000, 430 с.
- Patrin G.S., Yakovchuk V.Yu., Velikanov D.A. // Phys. Lett. A. 2007. V. 363. P. 164.
- Harada Y., Nakanishi Y., Daibo M. et al. // Physica B. 2003. V. 329–333. P. 1109.
- Skomski R. // J. Phys.: Condens. Matter. 2003. V. 15. № 7. P. R841.